# (12) 公 開 特 許 公 報 (A)

# - (11)特許出顧公開 号 特開平4-361088

(43)公開日 平成4年(1992)12月14日

(51) Int,Cl.* B 4 1 M	5/26	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G 1 1 B	7/24	5 1 6	7215 – 5D 8305 – 2H	B 4 1 M 5/26	Y

審査請求 未請求 請求項の数3(全22頁)

	<b>特願平3-137566</b>	(71)出願人	000005968
(22) 出願日	平成3年(1991)6月10日		三菱化成株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号
		(72)発明者	
		·	神奈川県横浜市緑区鴨志田町1000番地 三
			菱化成株式会社総合研究所内
		(72)発明者	今村 佰
			神奈川県横浜市緑区鴨志田町1000番地 三
		ĺ	菱化成株式会社総合研究所内
		(74)代理人	弁理士 重野 剛

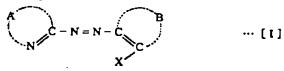
### (54) 【発明の名称】 光記録媒体

# (57)【要約】

【目的】 耐光性に優れた高反射率光記録媒体を提供する。

【構成】 基板上に記録層、金属反射層及び保護層を順次積層してなる光記録媒体であって、65%以上の反射率を有する光記録媒体において、該記録層が、下記一般式 [I]で示されるアゾ系化合物と金属とのアゾ金属キレート化合物の1種又は2種以上を含有する光記録媒体。

# 【化19】



(式中、Aはそれが結合している炭素原子及び窒素原子と一緒になって複素環を形成する残基を表わし、Bはそれが結合している二つの炭素原子と一緒になって芳香環又は複素環を形成する残基を表わし、Xは活性水素を有する基を表わす。)

【効果】 記録可能なCD媒体として有用な、高耐光性、高反射率光記録媒体が提供される。

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に記録層、金属反射層及び保護層を順次積層してなる光記録媒体であって、65%以上の反射率を有する光記録媒体において、該記録層が、下記一般式 [I] で示されるアゾ系化合物と金属とのアゾ金属キレート化合物の1種又は2種以上を含有することを特徴とする光記録媒体。

1

【化1】

(式中、Aはそれが結合している炭素原子及び窒素原子と一緒になって複素環を形成する残基を表わし、Bはそれが結合している二つの炭素原子と一緒になって芳香環又は複素環を形成する残基を表わし、Xは活性水素を有する基を表わす。)

【請求項2】 アゾ化合物が下記一般式 [II] で示される化合物であることを特徴とする請求項1に記載の光 20 記録媒体。

[化2]

$$R^{i} = N - D - N = \Pi$$

$$R^{i} = \Pi$$

(式中、Aはそれが結合している炭素原子と窒素原子と一緒になって複素環を形成する残基を表わし、R<sup>1</sup>及びR<sup>2</sup>はそれぞれ独立して水素原子、置換されていても良いアルキル基、置換 30 されていても良いアルケニル基又は置換されていても良いシクロアルキル基を表わし、Xは活性水素を有する基を表わす。環Dは置換基を有していても良い。)

【請求項3】 アゾ化合物が下記一般式 [III] で示される化合物であることを特徴とする請求項2に記載の 光記録媒体。

[化3]

$$C - N = N - D - N = R^{1} - \cdots = R^{2}$$

$$SO_{1}H$$

(式中、Aはそれが結合している炭素原子と窒素原子と 一緒になって複素環を形成する残基を表わし、R<sup>1</sup>及び R<sup>2</sup>はそれぞれ独立して水素原子、置換されていても良いアルキル基、置換されていても良いアリール基、置換されていても良いアリール基、置換されていても良いシクロアルキル基を表わす。環Dは置換基を有していても良い。)

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は光記録媒体に係り、詳しくは、記録層にアゾ化合物と金属とのアゾ金属キレート化合物を含有する、65%以上の反射率を有する高反射率光記録媒体に関する。

2

[0002]

【従来の技術】レーザーを用いた光学記録は、高密度の情報記録保存及び再生を可能とするため、近年特にその開発が進められている。光学記録の一例としては、光ディスクを挙げることができる。一般に光ディスクは、円形の基体に設けられた薄い記録層に、1μm程度に集束したレーザー光を照射し、高密度の情報記録を行うものである。その記録は、照射されたレーザー光エネルキーの吸収によって、その個所の記録層に、分解、蒸発、の吸収によって、その個所の記録層に、分解、蒸発、配録された情報の再生は、レーザー光により変形が起きている部分と起きていない部分の反射率の差を読み取ることにより行われる。従って、記録層はレーザー光のエネルギーを効率良く吸収する必要があり、このため、レーザー吸収色素が用いられている。

【0003】従来、この種の光学的記録媒体としては、種々のものが知られているが、近年、特に、コンパクトディスク(CD)が広く家庭に普及している。CDは、アルミニウム等の金属の反射層を有するもので、再生専用タイプの媒体である。これに対して最近になって、記録できる(追記型)タイプのCD媒体の提案がなされているが、市販のCDプレイヤーとの互換性のためには、反射率65%以上の高い反射率の記録媒体であることが要求される。このような高反射率の媒体として、例えば、特開平2-42652号、特関平2-87339号、特開平2-87340号等には、シアニン系色素を記録層として設けたものが開示されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記従来のシアニン系色素を主として用いた媒体は、溶解性が高く、 塗布によるコーティングが可能であるという利点の反面、耐光性が劣るという問題点を有している。

【0005】本発明は上記従来の問題点を解決し、耐光性に優れた高反射率光記録媒体を提供することを目的とする。

40 [0006]

【課題を解決するための手段】請求項1の光記録媒体は、基板上に記録層、金属反射層及び保護層を順次積層してなる光記録媒体であって、65%以上の反射率を有する光記録媒体において、該記録層が、下記一般式[1]で示されるアゾ系化合物と金属とのアゾ金属キレート化合物を1種又は2種以上含有することを特徴とする。

[0007]

【化4】

50

$$\begin{array}{c} X \\ X \\ C \end{array} \qquad \cdots \qquad \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

【0008】(式中、Aはそれが結合している炭素原子 及び窒素原子と一緒になって複素環を形成する残基を表 わし、Bはそれが結合している二つの炭素原子と一緒に なって芳香環又 は複素環を形成する残基を表わし、 Xは 活性水素を有する基を表わす。)請求項2の光記録媒体 10 は、請求項1の光記録媒体において、アゾ化合物が下記 一般式【II】で示される化合物であることを特徴とす る.

[0009]

[化5]

$$\begin{array}{c} R \\ N \end{array} = N - \begin{array}{c} D \\ X \end{array} \qquad \cdots \quad \begin{bmatrix} \Pi \end{bmatrix}$$

【0010】 (式中、Aはそれが結合している炭素原子 20 と窒素原子と一緒になって複素環を形成する残基を姿わ し、 $R^{\dagger}$ 及び $R^{\dagger}$ はそれぞれ独立して水素原子、置換され ていても良いアルキル基、置換されていても良いアリー ル基、置換されていても良いアルケニル基又は置換され ていても良いシクロアルキル基を表わし、Xは活性水素 を有する基を表わす。環Dは置換基を有していても良 い。)請求項3の光記録媒体は、請求項2の光記録媒体 において、アゾ化合物が下記一般式[III]で示され る化合物であることを特徴とする。

[0011]

【化6】

$$\begin{array}{c} R \\ C - N = N - D \\ SO_A H \end{array} \qquad \cdots \quad \begin{bmatrix} \blacksquare \end{bmatrix}$$

【0012】 (式中、Aはそれが結合している炭素原子 と窒素原子と一緒になって複素環を形成する残基を表わ し、R¹及びR²はそれぞれ独立して水素原子、置換され ていても良いアルキル基、置換されていても良いアリー ル基、置換されていても良いアルケニル基又は置換され ていても良いシクロアルキル基を表わす。環Dは置換基 を有していても良い。)以下に本発明を詳細に説明す る。一般式 [I] で示されるアソ系化合物において、A はそれが結合している炭素原子及び窒素原子と一緒に複 素環を形成する残基を表わし、好ましくは、少なくとも 1個の5~7員の複素環を形成するのに必要な複数個の 原子を表わす。Aにより形成される複素環上の水素原子 は1つ以上の置換基で置換されていても良い。この場 合、置換基としては、アルキル基、アルコキシ基、アリ

子、シアノ基、二トロ基、エステル基、カルパモイル 基、アシル基、アシルアミノ基、スルファモイル基、ス ルホンアミド基、アミノ基、アルキルアミノ基、アリー ルアミノ基、ヒドロキシル基、フェニルアゾ基、ピリジ ノアゾ基等が挙げられ、置換基のうち好ましいものとし ては、炭素数1~25の置換されていても良いアルキル 基、炭素数8~25の置換されていても良いアルコキシ 基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、炭素数1~2 5 の置換されていても良いアルキルスルファモイル基、 炭素数6~30の置換されていても良いフェニルスルフ ァモイル基、フェニルアゾ基、ピリジノシゾ基、炭素数 1~25のエステル基、炭素数1~25のカルパモイル **基、炭素数1~25のアシル基、炭素数1~25のアシ** ルアミノ基、炭素数 1~25のスルホンアミド基、下記 一般式[IV]で示されるアルキルアミノ基、アリール アミノ基、水素基等が挙げられる。

[0013]

【化7】

【0014】(式中、R\*及びR\*は水素原子、炭素数1 ~25の置換されていても良いアルキル基又はフェニル 基を表わす。R¹及びR⁴は一緒になって5又は6員環を 形成しても良い。) Aにより形成される複素環の中で好 ましいものとしては、チアソール頃、ペンゾチアソール 環、ピリドベンゾチアゾール環、ベンゾピリドチアゾー ル環、ピリドチアゾール環、ピリジン環、キノリン環等 が挙げられる。

【0015】また、一般式[1]で示されるアゾ系化合 物において、Bはそれが結合している二つの炭素原子と 一緒になって芳香環又は複素環を形成する残基を表わ し、好ましくは、少なくとも1個の5~7員の芳香環又 は複素環を形成するのに必要な複数個の原子を表わす。 Bにより形成される環上の水素原子は1つ以上の置換基 で置換されていても良い。この場合、置換基としては、 アルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アラル キル基、アリール基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ 基、エステル基、カルバモイル基、アシル基、アシルア ミノ基、スルファモイル基、スルホンアミド基、アミノ 基、アルキルアミノ基、アリールアミノ基、ヒドロキシ ル基等が挙げられ、置換基のうち好ましいものとしては、 **炭素数1~25の置換されていても良いアルキル基、炭** 素数8~25の置換されていても良いアルコキシ基、ハ ロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、炭素数1~25の置 換されていても良いアルキルスルファモイル基、炭素数  $6 \sim 30$  の置換されていても良いフェニルスルファモイ ル基、フェニルアゾ基、ピリジノアゾ基、炭素数1~2 5のエステル基、炭素数1~25のカルパモイル基、炭 ールオキシ基、アラルキル基、アリール基、ハロゲン原 50 素数 1 ~ 2 5 のアシル基、炭素数 1 ~ 2 5 のアシルアミ

5

ノ基、炭素数1~25のスルホンアミド基、前記一般式 【【V】で示されるアルキルアミノ基、アリールアミノ 基、水素基等が挙げられる。

【0016】Bにより形成される環の中で好ましいもの としては、ベンゼン環、ナフタレン環、ピリジン環、ピ リドン環又はピラゾール環等が挙げられる。

【0017】更に、一般式 [I] で示されるアソ系化合 物において、Xとしては活性水素を有する基であれば良 く、特に制限されないが、好ましいものとしては、一〇 H. -COOH. -SO1H. -B (OH) 1. -HNS 10 O: R\*(R\*は水素原子、炭素数1~25の置換されて いても良いアルキル基又はフェニル基を表わす。)、-CONH<sub>2</sub>、-SO<sub>2</sub>NH<sub>2</sub>、-NH<sub>2</sub>等が挙げられ、特に 好ましいものとしては、-〇H、-С〇〇H、-S〇: H、-HNSO<sub>2</sub> R<sup>5</sup> (R<sup>5</sup>は前記定義に同じ。) が挙げ られる。なお、Xが-COOH、-OH、-SOIHな どのように陰イオンを解離し得る基である場合には、ア ゾ金属キレート化合物の形成に際してはこのままの形で 用いても良く、また、陽イオンとの塩の形で用いても良 の陽イオン又はP\*(Ph)、N\*(C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>)<sub>4</sub>、N\*(C ·H·(n))·、Ph-N·(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>等の有機系の陽イ オンが挙げられる(なお、上記においてPhはペンセン 核を示す。)。

【0018】一般式 [1] で示されるアゾ系化合物の中 で好ましいものとしては、前記一般式 [ 1 1 ] で示され るアゾ系化合物が、また、特に好ましいアゾ系化合物と しては、前記一般式 [ I I I ] で示されるアソ系化合物 が挙げられる。なお、類Dの置換基としては、アルキル 基、アルコキシ基、ハロゲン原子が好ましい。

【0019】このようなアゾ系化合物とともにアゾ金属 キレート化合物を形成する金属としては、一般に該アソ 化合物とキレート化合物を形成する能力のある金属であ れば良く、特に制限はないが、ニッケル(Ni)、コパ ルト (Co)、鉄 (Fe)、ルテニウム (Ru)、ロジ ウム (Rh)、パラジウム (Pd)、銅 (Cu)、オス **ミウム(Os)、イリジウム(Ir)、白金(Pt)等** の遷移元素が好ましく、特にNi、Coである場合が好 ましい。これらは製造時Ni (CH, COO) 1、NiC l<sub>2</sub>、CoCl<sub>2</sub>、Co(BF<sub>4</sub>)<sub>2</sub>、Co(CH<sub>3</sub>CO 40 ン樹脂等が挙げられるが、生産性、コスト、耐吸湿性の O) z等の塩の形で用いられ、Ni<sup>11</sup>、Co<sup>21</sup>、Co<sup>31</sup> 等が配位したキレート化合物として得られる。

【0020】本発明において用いられるアゾ金属キレー ト化合物の合成は、例えば、「古川; Analytic a Chimica Acta 140 (1982) 2 81-289」の記載に準じて行なうことができる。具 体的には、前記一般式 [ I I ] で示されるアゾ系化合物 の金属キレート化合物は、まず、下記一般式 [V] で示 されるアミノ化合物を、常法に従って、ジアゾ化し、下 導体とカップリングして前記一般式 [11] で示される アゾ化合物を得、次いで得られたアゾ化合物と金属塩と を水及び/又はジオキサン、テトラヒドロフラン、アセ トン、エタノール等の有機溶媒中で反応させることによ って製造することができる。

[0021]

[化8]

$$\begin{array}{c}
D \\
N \\
R
\end{array}$$
... [VI]

【0022】(式中、A、並びに、環D、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>及び Xは前記定義に同じ。) 上記アソ金属キレート化合物の 製造に用いるNi<sup>2+</sup>、Co<sup>2+</sup>等の金属塩の陰イオンとし ては、好ましくはSCN‐、SbF。‐、CI‐、Br‐、 F', ClO4', BF4', PF4', CH2COO', TI い。陽イオンとしては、Na\*、Li\*、K\*等の無機系 20 Fs2-、SiFs2-、ZrFs2-、Ph-SO3-、CH3-Ph-SO<sub>3</sub> 、B (Ph) 。等の一価または二価の陰イ オンが好ましく、特にBFに、PFに、CH,COOが 好ましく用いられる(なお、Phはペンゼン核を示 す.).

【0023】次に本発明の光記録媒体の構成について説

【0024】本発明の高反射率光記録媒体は、基本的に は基板上に、少なくとも1種以上の前記アソ金属キレー ト化合物を含む記録層、金属反射層及び保護層を順次積 磨した層構成をとる。

【0025】本発明における基板としては、使用するレ ーザー光に対して透明又は不透明のいずれでも良い。基 板の材質としては、ガラス、プラスチック、紙、板状又 は箔状の金属等の一般の記録材料の支持体が挙げられる が、プラスチックが種々の点から好適に使用できる。プ ラスチックとしては、アクリル樹脂、メタクリル樹脂、 酢酸ビニル樹脂、塩化ビニル樹脂、ニトロセルロース、 ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリカーポネ 一ト樹脂、ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂、ポリサルホ 点から射出成形型のポリカーポネート樹脂基板が特に好 ましく用いられる。

【0026】本発明の光学的記録媒体における、前記ア ゾ金属キレート化合物を含有する記録層は、膜厚100  $A\sim 5 \mu m$ であることが好ましく、更に好ましくは1000Å~3μmである。

【0027】成膜法としては、真空蒸着法、スパッタリ ング法、ドクタープレード法、キャスト法、スピナー 法、浸漬法など一般に行われている薄膜形成法で成膜す 記一般式  $\{V\mid I\}$  で示される置換アニリンスルホン酸誘 50 ることができるが、量産性、コスト面等からスピナー法

が好ましい。スピナー法による成膜の場合、回転数は5 00~5000 r. p. m. が好ましく、スピンコート の後、必要に応じて加熱或いは溶媒蒸気にあてる等の処 理を行うことができる。なお、成膜に際しては、必要に 応じてパインダーを使用することもできる。 パインダー としては、ポリピニルアルコール、ポリピニルピロリド ン、ケトン樹脂、二トロセルロース、酢酸セルロース、 ポリピニルブチラール、ポリカーポネート等の既知のも のが用いられる。また、記録層は、その安定性や耐光性 キレート化合物(例えば、アセチルアセトナートキレー ト、ピスフェニルジチオール、サリチルアルデヒドオキ シム、ピスジテオーαージケトン等)を含有しても良 く、更に同系統の色素或いはトリアリールメタン系色 素、アゾ染料、シアニン系色 素、スクワリリウム系色 素、ニッケルーインドアニリン系色素等の他系統の色素 を併用することもできる。ドクターブレード法、キャス ト法、スピナー法、投債法、特にスピナー法等の塗布方 法により配録層を形成する場合の塗布容媒としては、テ トラフルオロプロパノール、オクタフルオロペンタノー 20 ル、テトラクロロエタン、プロモホルム、ジブロモエタ ン、ジアセトンアルコール、エチルセロソルブ、キシレ ン、3 - ヒドロキシー3 - メチルー2 - プタノン、クロ ロペンゼン、シクロヘキサノン、乳酸メチル等の沸点1 20~160℃のものが好適に使用される。

【0028】この中でも、生産性、コスト、耐吸湿性に 優れる射出成形ポリカーポネート樹脂基板に対して、該 基板をおかすことなく好適に使用できる溶媒として、特 にジアセトンアルコール、3-ヒドロキシ-3-メテル ロソルブ、エチルセロソルブ等のセロソルブ系容媒;テ トラフルオロプロパノール、オクタフルオロペンタノー ル等のパーフルオロアルキルアルコール系溶媒:乳酸メ チル、イソ酪酸メチル等のヒドロキシエステル系溶媒が 挙げられる。

【0029】金属反射層としては、金(Au)、銀(A g) 、 銅(C u )、アルミニウム(A I )等の金属或い はこれらの合金が挙げられる。

【0030】保護層としてはJIS K5400規定に よる鉛筆硬度試験でH以上の硬度を有する化合物がキズ 40 防止の関点から有効で、この条件を満たす限り任意の化 \*

\*\*合物が使用できるが、製造工程の簡便さから、スピンコ ート法で塗布できるものが好ましい。 スピンコート法、 その他通常の塗布法で成膜できる保護層材料としては、 シリコーン系、アクリル系、メラミン系、エポキシ系な どの熱硬化型樹脂、アルキルトリアルコキシシラン、テ トラアルコキシシラン等の部分共加水分解物や、それら にコロイダルシリカを配合したシリコーン系ハードコー ティング剤、及びアクリレート系等の光重合系フォトポ リマー、光架橋性フォトポリマー、アジド系フォトポリ 向上のために、一重項酸素クエンチャーとして遷移金属 10 マー等が挙げられる。保護層の膜厚は、 $1\sim200\,\mu$ m、特に2~100 $\mu$ m程度であることが好ましい。

【0031】本発明の光記録媒体への記録は、記録層に 1 μ m程度に集束したレーザー光、好ましくは半導体レ ーザーの光を基板を通して照射することにより行う。レ ーザー光の照射された部分には、レーザーエネルギーの 吸収による、分解、蒸発、溶融等の記録層の熱的変形が 生じる。従って、レーザー光により熱的変形が起きてい る部分と起きていない部分の反射率の差を読み取ること により、記録された情報の再生を行うことができる。

【0032】なお、本発明の光学的記録媒体の記録、再 生に使用されるレーザー光として は、N2、He-C d、Ar、He-Ne、ルビー、半導体、色素レーザー 等が挙げられるが、特に軽量性、取扱いの容易さ、コン パクト性などの点から半導体レーザーが好適に使用され る.

### [0033]

【作用】前記一般式 [1]、特に前記一般式 [11]、 とりわけ前記一般式[III]で示されるアソ化合物と 金属とのアゾ金属キレート化合物は、塗布によるコーテ - 2 - プタノン等のケトンアルコール系溶媒;メチルセ 30 ィングが可能で、しかも耐光性に優れ、耐久性に優れた 高反射率光記録媒体を低 コストに提供することができ る.

#### [0034]

【実施例】以下に実施例を挙げて本発明をより具体的に 説明するが、本発明はその要旨を超えない限り、以下の 実施例に限定されるものではない。

【0035】実施例1

(a) 光記録媒体の製造

[0036]

【化91

【0037】上記構造式(1)で示されるアゾ化合物の Niキレート化合物 0. 15 g をオクタフルオロペンタ ノール 7. 5gに溶解し、0. 2 2μmのフィルターで

Α、幅 0、 7 μ m の溝 (グループ) 付き、射出成形ポリ カーポネート樹脂基板 (5インチ) 上に満下し、スピナ 一法により500ァpmの回転数で塗布した。塗布後、 建過して溶解液を得た。この溶液 5 m l を深さ 7 0 0 50 6 0 ℃で 1 0 分間乾燥した。塗布膜の最大吸収波長は 6

45及び712nmであった。次に、この塗布膜の上 に、スパッタリング法により、膜厚2000AのAu膜 を成膜し、反射層を形成した。更に、この反射層の上に 紫外線硬化性樹脂をスピンコートし、これに紫外線を照 射して硬化させ、厚み10μmの保護膜を形成した。

## 【0038】(b)光記録

上記で得られた光記録媒体を1.2m/sで回転させな がら、中心波長780mmの半導体レーザー光で、記録 パワー7. 0mWで照射し、EFM信号を記録した。次 に、この記録部を中心波長780nmの半導体レーザー \* 10

\*を有するCDプレーヤーで再生したところ、良好な再生 信号を得た。本光記録媒体は、耐光性(キセノンフェー ドメーター加速テスト: 60時間) 及び保存安定性 (7 0℃、85%RH;500時間) 試験を行なった結果、 初期と比べて感度及び再生信号の劣化はみられず、光学 記録媒体として極めて優れたものであった。

10

【0039】実施例2

[0040]

【化101

## 【0041】 (a) 光記録媒体の製造

錯体として、上記構造式(2)で示されるアゾ化合物の N ! キレート化合物を用いたこと以外は、実施例1の (a) と同様にして、塗布、乾燥を行った。塗布膜の最 大吸収波長は644及び714mmであった。次に、こ 20 った結果、初期と比べて感度及び再生信号の劣化はみら の塗布膜の上に、スパッタリング法により、膜厚200 OAのAg膜を成膜し、反射層を形成した。更に、この 反射層の上に紫外線硬化性樹脂をスピンコートした後、 紫外線を照射して硬化させ、厚み10μmの保護層を形 成した。

## ※【0042】(b)光記録

上記で得られた光記録媒体について、実施例1の(b) と同様にして記録、再生を行ったところ、良好な再生信 号を得た。また、同様の耐光性及び保存安定性試験を行 れず、光学記録媒体として極めて優れたものであった。

【0043】実施例3

(a) 光記録媒体の製造

[0044]

【化11】

$$NC \longrightarrow N = N \longrightarrow N \xrightarrow{C_1H_1(n)} \cdots (3)$$

$$CH_{\bullet} \longrightarrow S \longrightarrow N = N \longrightarrow N \longrightarrow C_{\bullet}H_{\bullet} \longrightarrow \cdots (4)$$

$$SO_{\bullet}H$$

【0045】上記棋造式(3)で示されるアゾ化合物の N | キレート化合物 0. 10g及び上記構造式 (4) で 示されるアゾ化合物のNIキレート化合物0.05gの 配合組成物をテトラフルオロプロパノール7.5gに熔 解し、0.22μmのフィルターで濾過して溶解液を 得、実施例1の(a)と同様にして塗布、乾燥を行っ た。塗布膜の最大吸収波長は6.4.4及び7.1.2 nmであ 40 れず、光学記録媒体として極めて優れたものであった。 った。次に、この塗布膜の上に、スパッタリング法によ り、膜厚2000人のCu類を成膜し、反射層を形成し た。更に、この反射層の上に紫外線硬化性樹脂をスピン コートした後、紫外線を照射して硬化させ、厚み10 μ★

#### ★mの保護層を形成した。

## 【0046】(b)光記録

上記で得られた光記録媒体について、実施例1の(b) と同様にして記録、再生を行ったところ、良好な再生信 号を得た。また、同様の耐光性及び保存安定性試験を行 った結果、初期と比べて感度及び再生信号の劣化はみら

【0047】 実施例4

(a) 光記録媒体の製造

[0048]

【化12】

$$\begin{array}{c}
NC \\
F_{\bullet}C
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
N \\
N \\
N
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
N \\
N \\
N
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
C_{\bullet}H_{\bullet} & (n) \\
C_{\bullet}H_{\bullet} & (n)
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\dots & (5)
\end{array}$$

【0049】上記構造式(5)で示されるアゾ化合物の 50 Niキレート化合物 0.15gを乳酸メチル 7.5gに

溶解し、 0. 22 µmのフィルターで濾過して溶解液を 得、実施例1の(a)と同様にして塗布、乾燥を行っ た。塗布膜の最大吸収波長は646及び717mmであ った。次に、この塗布膜の上に、スパッタリング法によ り、膜厚2000AのAu膜を成膜し、反射層を形成し た。更に、この反射層の上にシリコン系ハードコート剤 をスピンコートして、厚み10μmの保護層を形成し た.

【0050】(b)光記録

(a) 光記録媒体の製造

[0052]

【化13】

【0053】錯体として、上記構造式 (6) で示される アゾ化合物のNiキレート化合物を用いたこと以外は実 施例1の(a)と同様にして塗布、乾燥を行った。塗布 膜の最大吸収波長は652及び723 nmであった。次 に、この塗布膜の上に、スパッタリング法により、膜厚 2000ÅのA1膜を成膜し、反射層を形成した。更 20 に、この反射層の上に紫外線硬化性樹脂をスピンコート した後、紫外線を照射して硬化させ、厚み10μmの保 護層を形成した。

【0054】(b)光記録

※上記で得られた光記録媒体について、実施例1の(b) と同様にして記録、再生を行ったところ、良好な再生信 号を得た。また、同様の耐光性及び保存安定性試験を行 った結果、初期と比べて感度及び再生信号の劣化はみら れず、光学記録媒体として極めて優れたものであった。

【0055】 実施例6

(a) 光記録媒体の製造

[0056]

【化14】

Ж

【0057】 錯体として、上記構造式 (7) で示される 30 上記で得られた光記録媒体について、実施例 1 の (b)アゾ化合物のNiキレート化合物を用いたこと以外は実 施例1の(a)と同様にして塗布、乾燥を行った。塗布 膜の最大吸収波長は642及び711nmであった。次 に、この塗布膜の上に、スパッタリング法により、膜厚 2000人のAg膜を成膜し、反射層を形成した。更 に、この反射層の上に紫外線硬化性樹脂をスピンコート した後、紫外線を照射して硬化させ、厚み10 μmの保 護層を形成した。

【0058】(b)光記録

と同様にして記録、再生を行ったところ、良好な再生信 号を得た。また、同様の耐光性及び保存安定性試験を行 った結果、初期と比べて感度及び再生信号の劣化はみら れず、光学記録媒体として極めて優れたものであった。

【0059】 実施例7

(a) 光記録媒体の製造

[0060]

【化15]

$$CF \longrightarrow S \longrightarrow N = N \longrightarrow N \xrightarrow{C_1H_1(n)} \cdots (8)$$

14

【0061】上記構造式(8)で示されるアゾ化合物の NIキレート化合物 0. 12g及び上記構造式 (9) で 示されるシアニン系色素 0. 03gの混合色素をオクタ フルオロペンタノール7.5gに溶解し、0.22μm のフィルターで濾過して溶解液を得、実施例1の (a) と同様にして塗布、乾燥を行った。塗布膜の最大吸収波 長は634、702及び716nmであった。次に、こ の塗布膜の上に、スパッタリング法により、膜厚200 OAのAg膜を成膜し、反射層を形成した。更に、この 反射層の上に紫外線硬化性樹脂をスピンコートした後、 紫外線を照射して硬化させ、厚み10μmの保護層を形 \*. \*成した。

【0062】(b)光記録

上記で得られた光記録媒体について、実施例1の(b) と同様にして記録、再生を行ったところ、良好な再生信 号を得た。また、同様の耐光性及び保存安定性試験を行 った結果、初期と比べて感度及び再生信号の劣化はみら れず、光学記録媒体として極めて優れたものであった。

【0063】実施例8

(a) 光記録媒体の製造

[0064]

【化16】.

$$N = N$$

$$N = N$$

$$C_*H_*(n)$$

$$C_*H_*(n)$$

$$C_*H_*(n)$$

10

【0065】上記構造式(10)で示されるアゾ化合物 のNiキレート化合物 0. 15gをテトラフルオロプロ パノール5gに溶解し、0.22μmのフィルターで減 過して溶解液を得、実施例1の(a)と同様にして塗 布、乾燥を行った。塗布膜の最大吸収波長は637及び 20 った結果、初期と比べて感度及び再生信号の劣化はみら 697 nmであった。次に、この塗布膜の上に、スパッ タリング法により、膜厚2000AのAu膜を成膜し、 反射層を形成した。更に、この反射層の上に紫外線硬化 性樹脂をスピンコートし、これに紫外線を照射して、硬 化させ、厚み10μmの保護層を形成した。

※【0066】(b)光記録

上記で得られた光記録媒体について、実施例1の(b) と同様にして記録、再生を行ったところ、良好な再生信 号を得た。また、同様の耐光性及び保存安定性試験を行 れず、光学記録媒体として極めて優れたものであった。

【0067】実施例9

(a) 光記録媒体の製造

[0068]

[(L17]

$$N i^{2} \longrightarrow \begin{bmatrix} O & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ &$$

【0069】上記構造式(11)で示されるアゾ化合物 のNIキレート化合物 0. 14g及び上記構造式 (1 2) で示されるNiインドアニリン系色素 0.01gの 混合色素をジアセトンアルコール5gに溶解し、0.2 2μmのフィルターで濾過して溶解液を得た。この溶液 リカーポネート樹脂基板上に滴下し、スピナー法により 700 r pmの回転数で塗布した。塗布後、60℃で1 0分間乾燥した。塗布膜の最大吸収波長は642、71 1及び805nmであった。次に、この塗布膜の上に、 スパッタリング法により、膜厚2000人のAu膜を成 膜し、反射層を形成した。更に、この反射層の上に紫外 線硬化性樹脂をスピンコートし、これに紫外線を照射し て、硬化させ、厚み10μmの保護層を形成した。

【0070】(b)光記録

上記で得られた光記録媒体について、実施例1の(b) と同様にして記録、再生を行ったところ、良好な再生信 5 m l を実施例 l の (a) で用いたと同様の射出成形ポ 40 号を得た。また、同様の耐光性及び保存安定性試験を行 った結果、初期と比べて感度及び再生信号の劣化はみら れず、光学記録媒体として極めて優れたものであった。

【0071】 実施例10

(a) 光記録媒体の製造

[0072]

【化18】

15

$$NC$$
 $NC$ 
 $NC$ 

【0073】上記構造式 (13) で示されるアゾ化合物 のNiキレート化合物 0.15 gをテトラフルオロプロ パノール 5 gに溶解し、0. 2 2 μ mのフィルターで確 過して溶解液を得、実施例1の(a)と同様にして塗 714 nmであった。次に、この強布膜の上に、スパッ タリング法により、膜厚2000AのAu膜を成膜し、 反射層を形成した。更に、この反射層の上にエポキシ系 熱硬化性樹脂をスピンコートし、これを熱で硬化させ、 厚み10μmの保護層を形成した。

# 【0074】(b)光記録

上記で得られた光記録媒体について、実施例1の(b) と同様にして記録、再生を行ったところ、良好な再生信 号を得た。また、同様の耐光性及び保存安定性試験を行 った結果、初期と比べて感度及び再生信号の劣化はみら 20 【表1】

れず、光学記録媒体として極めて優れたものであった。 【0075】実施例11

実施例 $1\sim10$ において用いた化合物の代わりに、表1~13に示したアゾ化合物と金属とのアゾ金属キレート 布、乾燥した。塗布膜の最大吸収波長は643nm及び 10 化合物の単体或いは混合系を使用して得た溶液を基板上 に強布して、その他は同様にして光学記録媒体を得た。 なお、塗布膜の最大吸収波長は表1~13に示す通りで あった。得られた光記録媒体について、実施例1の (b) と同様にして記録、再生を行ったところ、いずれ も感度が良好で、良好な再生信号を得た。また、同様の 耐光性及び保存安定性試験を行った結果、初期と比べて 感度及び再生信号の劣化はみられず、光学記録媒体とし て極めて優れたものであった。

[0076]

17	(10)			18
No.	アゾ化台	金属イオン	強イオン	是大级 权被是 (nm)
11 – 1	O.M. C.H. SO.H	Ni <sup>2+</sup>	_	648. 716
11-2	E,CO,S N-N-N-C,E, SO,H	NI <sup>2+</sup>	1	614, 676
11 - 3	C.H. SO.H OCH.	Co <sup>2+</sup>	ł	652, 717
11 – 4	O,M SOLR SCLR	Ni <sup>2+</sup>	ı	648. 713
11-5	C.E. SO.H	Ni <sup>2+</sup>	-	629, 694
11 – 6	O SO'H C'E' OCE' OCE'	N1 <sup>2+</sup>	-	667, 737
11 - 7	C R C.E.  O.N N N N C.E.  SOLH	Ni <sup>2+</sup>	-	653, 724

【0077】 【安2】

7.
13

No.	アゾ化合物	<b>全男</b> イオン	強イオン	最大级 収效是 (nn)
11 – 6	CE-0-S SO,H C.E.	Ni <sup>2+</sup>	_	640, 706
11 - 9	ELCOC SCH SCH CE	Ni 2+	_	649, 715
11-10	C.E. SOLH	Ni <sup>2+</sup>	-	648, 716
11-11	COOH C.H.	Co <sup>2+</sup>	C 2-	612, 637
11-12	COOH C.H.	Ni <sup>2+</sup>	-	643. 689
11-13	H,C COOH CH.	Co <sup>2+</sup>	-	625, 686
11-14	SO,H	Co <sup>2+</sup>	-	627. 689

[0078]

【表3】

No.	アゾ化合物	<u>金属</u> イオン	強イオン	最大级 収施長 (nm)
11-15	BT CES	Ni <sup>2+</sup>	-	622. 684
11-16	FaC SOLE OCH. SOLE C.H.	.Ni <sup>2+</sup>	-	633, 701
11-17	NC SOLH C.H. SOLH	Nl <sup>2+</sup>	-	843, 712
11-18	NC T=EC S N-N-N-C,E, SOLH	Ni <sup>2+</sup>	_	641, 709
11-19	HC,O,C C-HC SO,H C,E, SO,H	Ni <sup>2+</sup>	-	643, 707
11-20	O.M.—SO.H.—N.—C.E.  SO.H.—C.E.	Ni <sup>2+</sup>	_	<b>84</b> 5, <b>7</b> 15
11-21	C.H. SO.H	Ni <sup>2+</sup>	_	<b>65</b> 0, <b>7</b> 19

【0079】 【表4】

23	_	•		24
No.	アゾ化合物	金属イオン	油イオン	是大级 仅进是 (nm)
11-22	SO,H C.E.	Ni <sup>2+</sup>	_	662, 726
11-29	SOLE SOLE	Co2+	-	648, 713
11-24	H.CO. SOLH OCH. SOLH	Co <sup>2+</sup>	-	662, 726
11-25	E,C,O, SO,R C,E, SO,R	Ni <sup>2+</sup>	-	665. 721
11-26	HC SOLH C.E.	Ni 2+	-	<b>625</b> , 691
11-27	H,CO SOLH C.H.	Co <sup>21</sup>	-	667, 794
11-28	H,C,C,E, SO,H	Ni 2+	-	625, 689

[0080] 【表5]

25				26
No.	アゾ化合物	金属イオン	油イオン	最大级 权被是 (grg)
11-29	H.C. N=N-N-C.E.	Ni <sup>2+</sup>	_	<b>623.</b> 689
11-30	NC SOLH CLEL	N1 <sup>2+</sup>	-	824, 690
11-31	C & -N=N-N-C.H.  C.H.	Co <sup>3+</sup>	BF.	630
11-32	C.E.	Co <sup>3+</sup>	C &-	613
11-33	NC CH. SO,H	Ni <sup>2+</sup>	-	
11-34	BLC SO,H SO,H C,H, SO,H	Ni <sup>2+</sup>	-	644. 713
11-35	OEC S N=N - N - C, E, C,	N1 <sup>2+</sup>	-	627, 693

[0081] [表6]

558, 608, 650

Ni<sup>2+</sup>

				28
No.	アゾ化合物	金属イオン	強イオン	(DEC)
11-36	SO,H	Ni 2+	-	643. 710
11-37	CEL HC C.E. SO.E	NI 2+	-	642, 712
11-38	Br CH <sub>a</sub> COOH CH <sub>a</sub>	MI <sub>S+</sub>	-	622, 684
11-39	H,CO S N=N C,H, C,H,	Ni <sup>2+</sup>	-	628, 686
11-40	ELC S H-N-C.E.	Ni <sup>2+</sup>	-	628, 690
	CAL S. OCE.			

[87]

29	(10)			<b>3</b> 0
No.	アゾ化合物	金馬 イオン	強イオン	是大役 収放是 (nm)
11-43	HC S NSOCAR CAL	C¤2+	1	603
11-44	O'M C'H' N20'C'B'	N1 <sup>2+</sup>	<b>-</b>	595
11-45	C & S Non-Cook CHa	Ni <sup>2+</sup>	-	624, 684
11-46	H <sub>2</sub> C S <sub>N=N</sub> S <sub>O,H</sub> C <sub>.H</sub> ,	Ni <sup>2+</sup>	ı	622, 686
11-47	Br N=N - N - C.H. COOH	Ni 2+	1	602. 655
11-48	C. R. ——————————————————————————————————	Co <sup>3+</sup>	I-	589. 628
11-49	NC T-HC S N=N C.E.	NI <sup>2+</sup>	-	862. 728

(16)

【表8】 [0083]

32

•	٠.
J	1

No.	アゾ化合物	金貝イオン	着イオン	最大級 収益長 (nm)
11-50	C.E. SOLE	Ni <sup>2+</sup>	_	625. 691
11-51	H-CO N-N-N-N-Y-C.E.	N1 <sup>2+</sup>	_	<b>634</b> , 703
11-52	ECO N SOLE OCE.	Ni 2+	~	666, 730
11-53	H-C S H-N C.H.	Ni <sup>2+</sup>		645, 715
11-54	Br New C.H.	Ni <sup>2+</sup>	-	594. 648
11-55	BLC S H-N-C-EL	NI <sup>2+</sup>	-	571
11-56	ECC SCH OCE.	Ni <sup>2+</sup>	-	646, 715

[0084]

【表9】

34

33

No.	アゾ化合物	金男 イオン	油イオン	极大级 权效是 (mm)
11-57	H.CO C.H. SO.H C.H.	Ni <sup>2+</sup>	-	653. 725
11-58	NC C=EC S N=N C.E.	N1 <sup>2+</sup>	-	644, 713
11-59	H,C,H, SO,H	N1 <sup>2+</sup>	-	623, 691
11-60	H.C. SOLH C.H. SOLH	Ni <sup>2+</sup>	-	645, 715
11-61	H <sub>2</sub> C COOH C.E.	Ni <sup>2+</sup>	ı	611. 678
11-62	S N-N-C.E.	Co <sup>2+</sup>	-	625, 687
11-63	N=N-SOLH C.E.	Ni <sup>2+</sup>	1	631, 697

[30085] [表11]

				36	
No.	アゾ化合物	金属イオン	強イオン	是大股 収施長 (nn)	
11-64	S N=H C.H.	Co <sup>2+</sup>	-	627, 689	

No.	アク化音楽	イオン	傷イオン	(nm)
11-64	SOLE C.E.	Co <sup>2+</sup>	-	627, 689
11-65	ECO S N-N-CE	N1 <sup>2+</sup>	-	636, 694
11-66	ELCO S N=N-C,EL	Co <sup>2+</sup>	-	633, 694
11-67	CH, S N-N-COOR CE, COOR	Ni <sup>2+</sup>	_	624. 681
11-68	COOH CE	Ni <sup>2+</sup>	-	618, 684
11-69	OHC SOLE CLE.	Ni <sup>2+</sup>		627, 694
11-70	ON CH CH. SOLE	Ni <sup>2+</sup>	-	662, 729

[0086]

【表11】

<i>3</i> 7				38
No.	アゾ化合物	金属イオン	強イオン	是大级 収放長 (nm)
11-71	ON OS SOM C.E.	N1 <sup>2+</sup>	1	637. 698
11-72	CAL N-N-N-CAL	Nl <sup>2+</sup>	-	<b>632,</b> 701
11-73	C &	‰³+	C & 0,	583, 629
11-74	H.C.OOC C.E. SOLH C.H.	Ni <sup>2+</sup>	-	675, 745
11-75	O.N C.B., SO.E OCH.	Ni <sup>2+</sup>	_	666. 732
11-76	NC H OCH, NC C-C S H-N C.H. SO,H	NI <sup>2+</sup>	_	587, 754
11-77	O.N. S. N.=N.—C.H.	N1 <sup>2+</sup>	-	640. 713

【0087】 【表12】

				40
No.	アゾ化合物	金属イオン	油イオン	是大级 仅进员 (mm)
11-78	Br - N-N-CEL	Pd	OCCE.	644, 708
11-79	C &-W=N-N-S A=N-C-E.	Ni 2+	_	640. 692
11-80	C 2 - N=N S N=N - C 2E.	Co <sup>2+</sup>	-	642, <del>69</del> 7
11-81	M-N-K-C2	Ni <sup>2+</sup>	-	591
11-82	LL S N-N CLL	Ni <sup>2+</sup>	-	643, 692
11-83	N=N-X-C.E.	Co <sup>2+</sup>	-	636, 700
11-84	N=N C,B,	Ni <sup>2+</sup>	-	642. 707
11-85	S H-N COOH C.B.	Co <sup>2+</sup>	-	651, 713

[0088]

【表13】

4	•
	ı

No.	アゾ化合物	金属イオン	油イオン	是大级 及数是 (III)
11-86	$N=N-\sum_{i=1}^{N}N-N-i$	Ni 2+	<b>-</b>	586
11-87	N=N S N-N C.E.	Ni <sup>2+</sup>	<del>-</del>	<del>6</del> 63, 718
11-88	N-N-N S N-N-C.E.	Ni <sup>2+</sup>	-	643. 702
11-89	O,N — K=N — C.E. COOH C.E.	Ni <sup>2+</sup>	-	649, 708
11-90	N-N-N S N-N COUR C.E.	Ni 2+		649, 708
11-91	N=N-S N=N-C.E. CODE	N1 <sup>2+</sup>		638, 698
11-92	N=N-N-N-N-N-N-N-CH.	NI <sup>2+</sup>	-	590, 644

【0089】 【発明の効果】以上詳述した通り、本発明の光記録媒体 によれば、高感度で耐光性、保存安定性に優れ、特に耐

光性に著しく優れ、例えば、記録可能なCD媒体として 有用な高反射率光記録媒体が提供される。